



## ILMS5360

Предельно допустимые значения параметров  $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

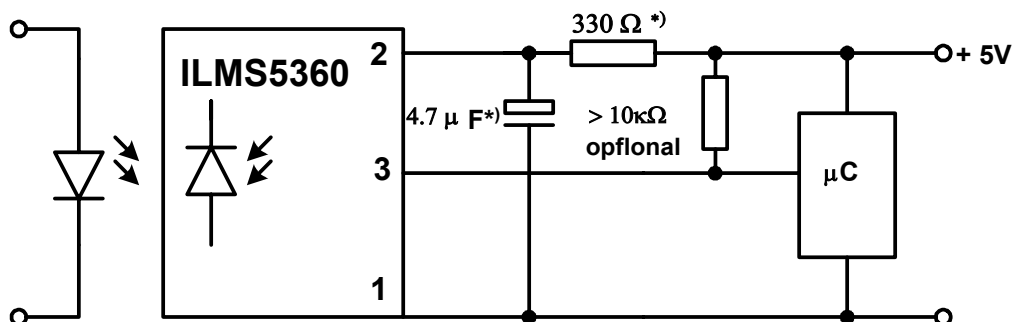
Наименование	Условия измерения	Обозначение	Значение	Ед.изм
Напряжение питания		$V_s$	$4.5 \div 5.5$	В
Ток питания		$I_s$	0.8	мА
Температура перехода		$T_j$	100	$^{\circ}\text{C}$
Температура хранения		$T_{stg}$	$-25 \div +85$	$^{\circ}\text{C}$
Рабочая температура		$T_{amb}$	$-25 \div +85$	$^{\circ}\text{C}$
Потребляемая мощность	( $T_{amb}=85^{\circ}\text{C}$ )	$P_{tot}$	5.0	мВт

Основные характеристики  $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

Наименование	Условия измерения	Обозначение	MIN	TYP	MAX	Ед. изм.
Ток потребления (Вывод 2)	$V_s = 5\text{ V}, E_v = 0$	$I_{SD}$	0.4	0.5	0.8	мА
Ток потребления (Вывод 2)	$V_s = 5\text{ V}, E_v = 40$ клк, солнечный свет	$I_{SH}$	-	1.0	-	мА
Выходное напряжение низкого уровня (Вывод 3)	$I_{OSL} = 0.5\text{ mA}$ , $E_e = 0.5\text{ мВт/м}^2$ , $f = f_0, t_{PI}/N = 0.4$ Тестовый сигнал*	$V_{OSL}$	-	-	250	мВ
Минимальная плотность мощности ИК-излучения	$t_{PO} = t_{PI} \pm 160$ мкс Тестовый сигнал	$E_{emin}$	0.6	0.4	-	мВт/м <sup>2</sup>
Максимальное излучение	Тестовый сигнал*	$E_{emax}$	-	-	20	Вт/м <sup>2</sup>

\*  $F_0 = 38\text{ кГц}$

### Схема подключения.



\*) - необходимо только для подавления помех источника питания + 5В.

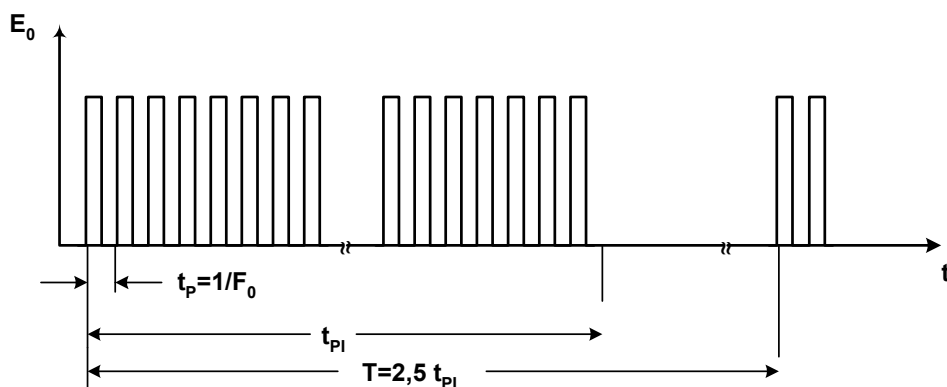


220108 Республика Беларусь, г. Минск,  
ул. Корженевского, 12,  
Факс: +375 (17) 278 28 22,  
Тел: +375 (17) 278 07 11, 212 24 70, 212 24 61,  
212 69 16  
E-mail: office@bms.by  
URL: www.bms.by

**БЕЛМИКРОСИСТЕМЫ**

## ILMS5360

## Входной тестовый сигнал



## Выходной сигнал

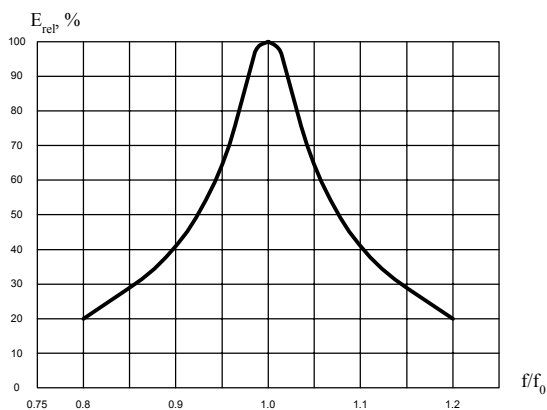
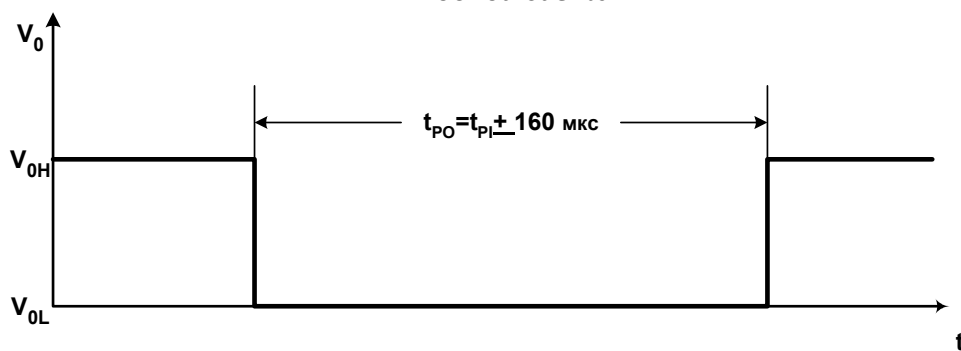


Рисунок 1 – Зависимость чувствительности как функция нормированной частоты,  $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$  (амплитудно-частотная характеристика).

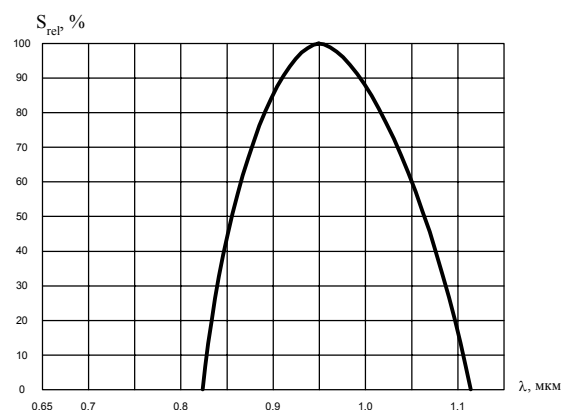
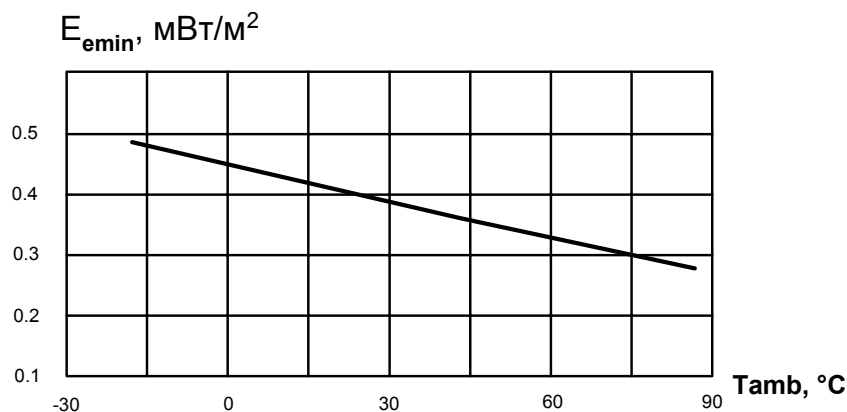


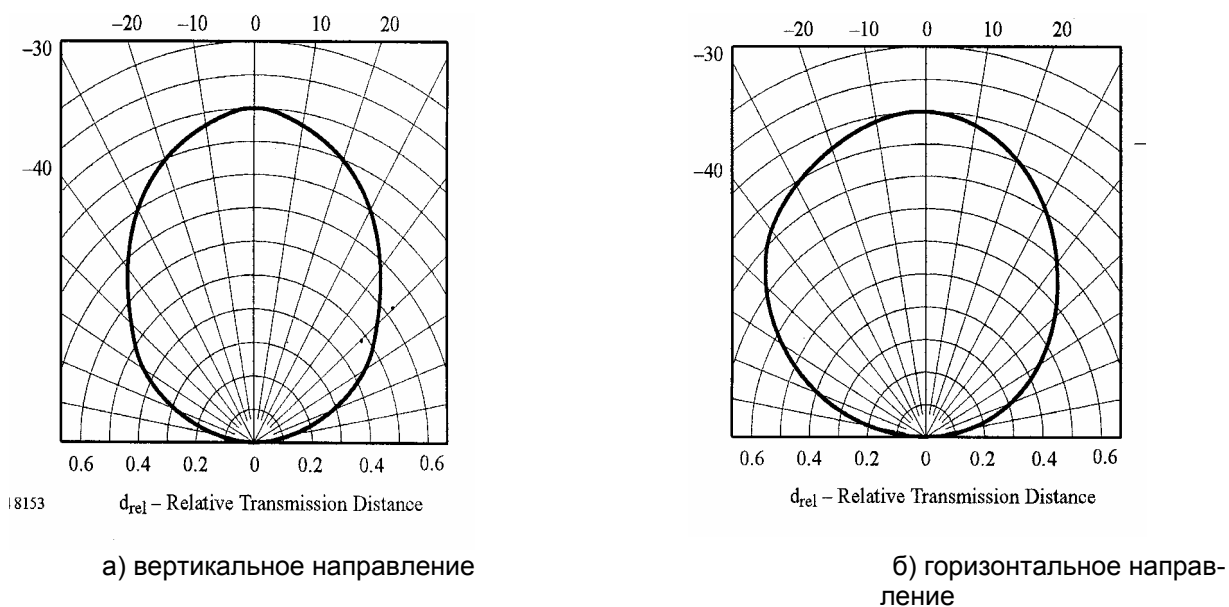
Рисунок 2 – Зависимость чувствительности от длины волны ИК-излучения при  $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$  (спектральная характеристика).



## ILMS5360



**Рисунок 3** – Зависимость параметра минимальная плотность мощности ИК-излучения от температуры среды (чувствительность микросхемы) при  $U_s = 5В$ .



**Рисунок 4** – Зависимость относительной чувствительности от величины угла поворота излучателя

